

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0106U007386

Відкрита

Дата реєстрації: 31-07-2006

Статус виконавця: 71 - співвиконавець

Реєстраційний номер РК головного виконавця:



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 07 - завдання органів виконавчої влади

КПКВК:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 24

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
-----	--------------

2. Замовник

Назва організації: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125438

Адреса: вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Дрогобицький р-н., Львівська обл., 82100, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380324431276

Телефон: 380324410474

E-mail: dekanat_sochum@ukr.net

3. Виконавець

Назва організації: Науково-виробниче підприємство "Електрон-Карат"-дочірнє підприємство ПрАТ "Концерн-Електрон"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23273999

Підпорядкованість: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Адреса: вул. Стрийська, 202, м. Львів, Львівська обл., 79031, Україна

Телефон: 2631065

E-mail: office@carat.electron.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Синтез зразків халькогенідних склоподібних напівпровідників, виготовлення зразків високої оптичної якості та оптимізація їх оптоелектронних параметрів

Назва роботи (англ)

Synthesis of chalcogenide glassy-like semiconductors, fabrication of samples with high optical quality and optimization of their optoelectronic parameters

Мета роботи (укр)

Метою роботи є синтез зразків бінарних, псевдобінарних, потрійних стехіометричних і нестехіометричних систем халькогенідних склоподібних напівпровідників (ХСН), виготовлення зразків високої оптичної якості та оптимізація їх оптоелектронних параметрів

Мета роботи (англ)

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інше

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Будуть отримані оптимальні оптоелектронні параметри функціональних середовищ на основі зразків ХСН шляхом їх хіміко-технологічної модифікації, включаючи і посттехнологічну обробку високо-енергетичним іонізуючим гама-випромінюванням

Галузь застосування:

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	07.2006	12.2006	Без звіту	Синтез зразків бінарних та псевдо-бінарних систем ХСН, виготовлення зразків високої оптичної якості, оптимізація їх оптоелектронних параметрів
2	01.2007	12.2007	Без звіту	Синтез зразків потрійних стехіометричних та нестехіометричних систем ХСН, виготовлення зразків високої оптичної якості, оптимізація їх оптоелектронних параметрів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 29.19.31

Індекс УДК: 537.311.322, 539.216.2

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Ваків Микола Михайлович (д. т. н., професор)

Керівники роботи:

Шпотюк Олег Йосипович (д. ф.-м. н., професор)

Відповідальний за подання документів: (Тел.:)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.